

半 导 体 学 报

第 11 卷 第 12 期 1990 年 12 月

目 录

- 电子辐照 N 型 LPE-GaAs 层中复合中心能级的研究 胡雨生 汪 乐 陈正秀 (889)
EL2 能级和光电离截面的计算 王传奎 徐婉棠 (896)
铬硅化物的形成及其界面反应 丁孙安 许振嘉 李宝骐 周一峰 (906)
离子注入快速热退火制造类视见函数光电探测器 郑国祥 邬建根 王昌平 朱景兵 屈逢源 周寿通 (915)
异质结绝缘栅场效应晶体管 (HIGFETs) 高场区静态特性模型和栅泄漏电流
研究 顾 聰 王德宁 王渭源 (922)
磁敏二极管的数值模拟 韩峰岩 徐启华 (931)
氩离子在反应离子腐蚀 III-V 族材料中的作用 李建中 (937)
- 研究简报**
- 冷发射电子束掺杂磷 李秀琼 王培大 马祥彬 王 纯 (942)
Ce-Si 多层膜中铈硅化物的形成 何 杰 许振嘉 钱家骏 王玉田 王佑祥 (946)
剩余杂质对 $Hg_{0.8}Cd_{0.2}Te$ 晶体光吸收的影响 王 珏 陆 卫 刘激鸣 俞振中 汤定元 (950)
反应溅射法制备掺硼的 a-Si:H(B) 薄膜的 ESR 研究 陈光华 徐进章 张仿清 (954)
低漏电高增益 InGaAs/InP SAGM 雪崩光电二极管
王树堂 曾 靖 李 锋 胡春阳 夏彩虹 孙 捷 樊爱香 (958)
薄膜 SOI 结构中反型层厚度与薄膜厚度的关系 夏永伟 王守武 (962)
- 研究快报**
- 氮离子注入对 GaAs 肖特基势垒性能影响的研究
张利春 高玉芝 宁宝俊 张 录 王阳元 (966)